

拒絶理由通知書

P.1

特許出願の番号	平成10年 特許願 第189654号
起案日	平成19年 5月11日
特許庁審査官	谷山 稔男 8909 2000
特許出願人代理人	鈴木 晴敏 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

理由1

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記のパブリケーションに記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

理由2

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記のパブリケーションに記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

◆理由1及び2について

- ・請求項 1-6
- ・引用文献等 1
- 引用文献1には次の発明が記載されている（【0051】～【0055】、図3）。
「ガラス基板の一方の面に1.5μmの感光性樹脂膜を形成する工程と、複数のパターンが少なくとも2μm以上離れて形成されるフォトリソマスクを用いて、前記感光性樹脂膜を露光、現像することにより、大突起及び小突起を形成する工程と、
前記大突起及び小突起が形成されたガラス基板を200℃で1時間加熱処理することにより、前記大突起及び小突起の角を丸くする工程と、

P.2

前記角を丸くされた大突起及び小突起の上に高分子樹脂膜を形成し、突起の間の部分の凹所を埋める工程と、
前記高分子樹脂膜の上に反射金属膜を形成する工程と、を行う反射板の製造方法。」

引用文献1記載の発明は、大突起及び小突起の最大傾斜角について明示の記載はないが、1.5μmの感光性樹脂膜を露光、現像した後、200℃で1時間加熱処理するという本願明細書記載（【0012】）の実施例と同様の工程を採用していることからみて、引用文献1記載の発明においても、大突起及び小突起の最大傾斜角は1.2°未満となっている蓋然性は高い。

また、引用文献1記載の発明において使用するフォトリソマスクは、パターンの間の距離が2μm以上であることから（本願明細書（【0011】）には、フォトリソグラフィの最小分解能として1μmが例示されている。）、得られる突起の間隙寸法がフォトリソグラフィの最小分解能と等しくなる蓋然性も高い。

したがって、請求項1-6に係る発明は、引用文献1記載の発明と同一である。また、仮に差違があったとしても想到容易である。

- ・請求項 7、8
- ・引用文献等 1
- 引用文献1（【0044】～【0049】、図1）には、引用文献1記載の発明である
ページ(1)

反射板を、反射型表示装置に使用することが記載されている。

- ・請求項 9、10
- ・引用文献等 1

引用文献 1（【0027】～【0043】、【0056】～【0073】、図5）には、光学位相補償板及び液晶層の位相差条件が記載されている。そして、光学位相補償板を四分の一波長板とし、液晶層が電圧無印加時に四分の一波長板として機能し、電圧印加時に当該機能を失うよう構成することにより、前記位相差条件を満たすことは、当業者であれば容易に想到できたことである。

引用文献等一覧

1 特開平6-167708号公報

先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野 IPC 602B 5/00-5/136
- ・先行技術文献 特開平8-166605号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がござい
ましたら下記までご連絡下さい。
特許審査第一部応用光学（光学要素・EL素子） 谷山稔男
TEL. 03（3581）1101 内線3269
FAX. 03（3501）0478

P.3

部長／代理 審査長／代理 審査官 審査官補
 鈴野 幹夫 谷山 稔男
 8621 8909
